第3章 研究で使用した設備、部材の概要

## 第3章 研究で使用した設備、部材の概要

## 3.1. 研究で使用した主要設備

本コンソーシアム研究で使用した主要設備を表 3.1.1 に示す。

表 3.1.1. 本コンソーシアム研究で使用した主要設備

装置名称	メーカー	型番	2014 年 3 月 の設置場所
セル自動配線装置	エヌ・ピー・シー	NTS-150-S-H-3K	九州
薄膜基板自動配線装置	エヌ・ピー・シー		九州
真空ラミネータ (2 台)	エヌ・ピー・シー	LM50x50S	つくば
真空ラミネータ	エヌ・ピー・シー	LM50x50	九州
真空ラミネータ	エヌ・ピー・シー	LM-SA-155X240- S	九州
シール材塗布・フレーム取付装置	ノードソン		九州
ソーラーシミュレータ	日清紡メカトロニクス	SPI-SUN SIMULATOR 1116N	つくば
ソーラーシミュレータ	ワコム電創	WPSS - 500S-50, AM1.5G	つくば
ソーラーシミュレータ	日清紡メカト ロニクス	PVS1222i-L	九州
ソーラーシミュレータ	山下電装		九州
水蒸気透過率測定装置	イリノイ	7200	つくば
エレクトロルミネセンス測定装置 (2 台)	アイテス	PVX100	つくば・九州
太陽電池変換効率分布測定装置	レーザーテッ ク	MP50	つくば
耐電圧試験装置(2台)	菊水電子工業	TOS9213S	つくば・九州
環境試験装置(2台)	エスペック	ARS-1100-J	九州
環境試験装置	エスペック	PR-4KP	九州
環境試験装置	エスペック	PSL-4KPH	九州
環境試験装置(2台)	エスペック	SMS-2S	九州
紫外光照射装置	ダイプラ・ウ ィンテス	WM-2	九州

複合加速劣化試験装置	スガ試験機	CCT-LX	九州
Xe 耐光性試験装置	スガ試験機	SX75	九州
引張り強度試験機	島津製作所	EZ-S	九州
分光測色計	コニカミノルタ	CM-700d	九州
赤外線サーモグラフィ装置	日本アビオニ クス	H2630	九州

九州センター内に設置した大型モジュール試作・評価装置の主な仕様は以下のとおりである。また、各装置の外観写真を図 $3.1.1 \sim 3.1.6$ に示す。

### 1) セル自動配線装置

- ・125 mm×125 mm の 2 本バスバーセル、156 mm×156 mm の 2 本もしくは 3 本バス バーセルに対応可能。
- ・セル厚み 160~350 μm に対応可能。
- ・処理速度 6.5 秒/セル以内。

### 2) 薄膜基板自動配線装置

- ・導電性粘着材付金属テープ、導電性ペーストタブ、異方導電フイルムのいずれかで配線可能。
- ・最大サイズ 1.1 m×1.4 m の任意サイズの薄膜太陽電池セルに対応可能。

#### 3) 真空ラミネータ

- ・最大  $1.5 \, \text{m} \times 2.4 \, \text{m}$  のサイズの太陽電池モジュールに対応可能。
- ・ラミネート温度は 30~180 ℃ ±10 ℃の範囲で制御可能。
- ・プレス圧は 0~1 kg/cm<sup>2</sup> の範囲で可変。
- ・モジュール1枚あたりに要する処理時間は36分(内、ラミネート時間は16分)。
- 4) シール材塗布・フレーム取付装置
  - ・最大 1.1 m×1.4 m のサイズの太陽電池モジュールに対応可能。
  - ・シリコーンもしくはブチルゴムに対応。
  - ・ペール缶用加熱溶解搬送機で溶かしたブチルゴムを、ヒーター付きパイプを経由し、 加熱型精密塗布機から所定量を吐出。
- 5) ソーラーシミュレータ
  - ・光源は Xe ランプ 2 灯 (ランプ長: 1.3 m) で、パルス状発光 (パルス幅 100 ms)。
  - ·有効照射面積 1.2 m×2.2 m。
  - ・JIS C8912「結晶系太陽電池測定用ソーラーシミュレータ」に適合。
- 6) 環境試験装置
  - ・最大 1.8 m×1.5 m×50 mmt サイズのモジュールを同時に 10 枚試験可能。
  - ·温度制御範囲-40 °C~120 °C。
  - ・温度安定性 85 ℃±2 ℃、-40 ℃±2 ℃。



図 3.1.1. セル自動配線装置の外観写真



図 3.1.2. 薄膜基板自動配線装置の外観写真



図 3.1.3. 真空ラミネータの外観写真



図 3.1.4. シール材塗布・フレーム取付 装置の外観写真



図 3.1.5. ソーラーシミュレータの外観写真



図 3.1.6. 環境試験装置の外観写真

## 3.2. 研究で使用した部材

本コンソーシアム研究でモジュール試作に使用した主要部材の一覧を表 3.2.1 に示す。

表 3.2.1. 本コンソーシアム研究でモジュール試作に使用した主要部材

部材	メーカー	型式等	主な仕様
PVセル	Q-Cells	Q6LTT3	156 mm x 156 mm, 3BB
		(多結晶シリコンセル)	t = 180/200 μm, Eff = 16.2/16.6 %
		Q6LTT3-G2	156 mm x 156 mm, 3BB
		(多結晶シリコンセル)	t = 200 μm, Eff = 17.0 %
	MOTECH	単結晶シリコンセル	125 mm x 125 mm, 2BB
	アルバック	アモルファスシリコンセ	186 mm 角 配線有/無
		ル	1400 mm x 1100 mm 配線有/無
	カラカ	薄膜シリコンセル (タンデ	186 mm 角 配線有/無
	カネカ	ム)	1200 mm x 998 mm 配線有/無
ガラッ	±0.20 →	白板強化ガラス	400 mm/180 mm 角, t = 3.2 mm
ガラス	旭硝子		1160 mm x 980 mm, t = 3.2 mm
		ENVA FIRST CONTRACT	400 mm x 400 mm, t = 450 μm
+4.1.++	ally as b	EVA, Fast Cure type	1120 mm x 150 m/R, t = 450 μm
封止材	サンビック	EVA, Standard Cure type	400 mm x 400 mm, t = 400 μm
			1020 mm x 150 m/R, t = 400 μm
	非公開	T/P/T	402 mm x 402 mm
			1000 mm x 30 m/R
			$T/P/T = 38 \mu m/250 \mu m/38 \mu m$
バックシート	非公開	P/A/P	402 mm x 402 mm
			1420 mm x 1120 mm
			1220 mm x 1018 mm
	三菱樹脂	シリカ蒸着	
絶縁フィルム	非公開	透明テドラーフィルム	紫外線吸収剤入, t = 50 μm
フラックフ	HOZAN	H-722	
フラックス	タムラ製作所	ULF-210RN	
難燃性テープ	寺岡製作所	630F #25 12 x 30 m	
端子箱	オーナンバ	PVU-B50	
		PVU-B62	
		PVU-B51	
フレーム	非公開	1170 mm x 990 mm	c-Si モジュール仕様
	非公開	1410 mm x 1110 mm	a-Si モジュール仕様
	非公開	1210 mm x 1008 mm	薄膜シリコンモジュール仕様
	新井精機	186 mm x 186 mm	c-Si モジュール仕様
フレーム	新井精機	192 mm x 192 mm	a-Si/薄膜シリコンモジュール仕様

フレーム	ケー・アイ・エス	407 mm x 407 mm	c-Si モジュール仕様	
配線材料	日立電線	SSA-SPS(2AG) 0.2x1.5	1.5 mm 幅, 鉛有, 銀有	
		A-SPS(2AG) 0.23x6.0	6.0 mm 幅, 鉛有, 銀有	
		SSA-TPS 0.2x1.5	1.5 mm 幅, 鉛フリー	
		A-TPS 0.23x6.0	6.0 mm 幅, 鉛フリー	
		A-TPS 0.1x2.0	2.0 mm 幅, 鉛フリー	
		A-TPS 0.1x5.0	5.0 mm 幅, 鉛フリー	
	丸正	Cu-O-100-2-B Sn/Ag/Cu	2.0 mm 幅, 鉛フリー	
		Cu-O-100-6-R Sn/Ag/Cu	6.0 mm 幅, 鉛フリー	
シール材	東レ・ダウコ ーニング	SH780	シリコーンシーラント	
	横浜ゴム	M-155P	ブチルゴム系ホットメルトタイプ	
	非公開		ガスケット	
ポッティング	東レ・ダウコ	PV-7321	の流泪入りノプ	
材	ーニング	F V-1021	<b>2</b> 液混合タイプ 	

# 3.3. モジュールの作製

試作した結晶系ミニサイズモジュール、薄膜系ミニサイズモジュール、結晶系フルサイズモジュール、薄膜系フルサイズモジュールの写真を、それぞれ図 3.3.1~3.3.5 に示す。



図 3.3.1. 試作した結晶系 4 セルサイズ モジュールの外観写真



図 3.3.2. 試作した薄膜系ミニサイズ モジュールの外観写真



図 3.3.3. 試作した結晶系フルサイズモ ジュールの外観写真

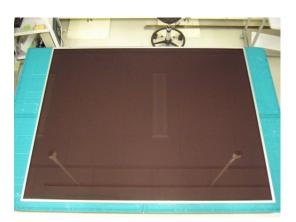


図 3.3.4. 試作した薄膜系 (アモルファス) フルサイズモジュールの外観写真



図 3.3.5. 試作した薄膜系 (タンデム) フルサイズモジュールの外観 写真

(独立行政法人産業技術総合研究所:井上 昌尚)